

半导体学报

第 11 卷 第 1 期 1990 年 1 月

目 录

- 消除边缘区效应的“三脉冲 DLTS”法及对 DX-中心俘获过程的测量
.....谢茂海 高季林 葛惟银 周 洁 (1)
- GaInAs/AlGaAs 应变量子阱结构的荧光特性.....王杏华 Reino Laiho (7)
- 测定离子注入单晶损伤与应变的双晶(n^+ , $-n^+$)排列方法.....李润身 H. K.
Wagenfeld J. S. Williams Stephen Wilkins and Andrew Stevenson (14)
- InP 单晶特性的低温光伏研究.....颜永美 (20)
- GaAs/GaAlAs 光双稳激光器稳态及动态特性的实验研究
.....王启明 吴荣汉 赵建和 刘文旭 张权生 (28)
- 双区共腔双稳激光器超短光脉冲输出特性分析.....赵建和 吴荣汉 (35)
- GaAs 双光束耦合中的普克尔效应.....王威礼 何雪华 让庆澜 张合义 (42)
- 快速热退火在硅中引入的缺陷的研究.....
.....陆 昉 陆 峰 孙恒慧 邱建根 (48)
- 一种用于 VLSI 工艺模拟的反应离子刻蚀速率模型 冯向明 阮 刚 (55)
- 研究简报**
- 双栅 MOSFET 高频特性的实验研究.....李元雄 张 敏 (63)
- 流体静压力下 $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ p-n 结的伏安特性
.....李齐光 姜 山 袁皓心 陈泉森 沈学础 (68)
- 研究快报**
- GaAs/Al_xGa_{1-x}As 超晶格中的纵光学声子模
.....汪兆平 韩和相 李国华 陈宗圭 钟战天 (72)
- 远场单瓣梯形沟道衬底内条形半导体激光器列阵.....
.....赵方海 杜国同 张晓波 高鼎三 (77)